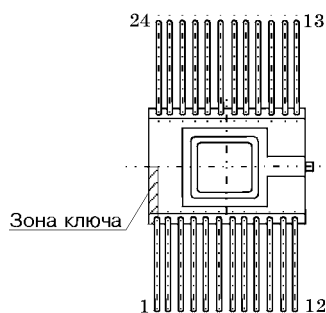


Оперативное запоминающее устройство (статическое) емкостью 16384 бит (2048 слов x 8 разрядов) в корпусе 4131.24-3.01

Схема расположения выводов

Содержание драгоценных
металлов в 1000 штук

Золото – 23,2527 г
Серебро – 50,1764 г
Цветные –

Назначение выводов

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
1	Вход адресный строки А7	13	Вход/выход третьего разряда данных DI03
2	Вход адресный строки А6	14	Вход/выход четвертого разряда данных DI04
3	Вход адресный строки А5	15	Вход/выход пятого разряда данных DI05
4	Вход адресный строки А4	16	Вход/выход шестого разряда данных DI06
5	Вход адресный столбца А3	17	Вход/выход седьмого разряда данных DI07
6	Вход адресный столбца А2	18	Вход сигнала разрешения CE
7	Вход адресный столбца А1	19	Вход адресный строки А10
8	Вход адресный столбца А0	20	Вход сигнала разрешения выхода DE
9	Вход/выход нулевого разряда данных DI 00	21	Вход сигнала записи/ считывания (WR/RD)
10	Вход/выход первого разряда данных DI01	22	Вход адресный строки А9
11	Вход/выход второго разряда данных DI02	23	Вход адресный строки А8
12	Общий вывод OV	24	Питание U _{CC}

Основные электрические параметры (+25±10, +85, +125, -60 °C)

			Обозна-	Норма				Единица
Параметр			чение	537РУ9А,В		537РУ9Б,Г		измере-
				не менее	не более	не менее	не более	ния
Выходное напряжение низкого уровня			U _{OL}					В
		t, °C						
	I _{OL} = 1,7мА	+25±10			0,3		0,3	
		-60,+85*, +125* ¹		–	0,4	–	0,4	
	R _L i 10 мОм	+25±10			0,05		0,05	
		-60,+85*, +125* ¹			0,1		0,1	
Выходное напряжение высокого уровня			U _{OL}					В
		t, °C						
	I _{OH} = 1,2мА	+25±10		2,6		2,6		
		-60,+85*, +125* ¹		2,4	–	2,4	–	
	R _L i 10 мОм	+25±10		U _{CC} -0,05		U _{CC} -0,05		
		-60,+85*, +125* ¹		U _{CC} -0,1		U _{CC} -0,1		
Напряжение питания в режиме хранения			U _{CCS}					В
		t, °C						
		+25±10		–	3	–	3	
		-60,+85*,+125* ¹			3,3		3,3	
Входное напряжение низкого уровня			U _{IL}					В
		t, °C						
		+25±10		–	0,4	–	0,4	
		-60,+85*,+125* ¹						

Параметр			Обозначение	Норма				Единица измерения
				537PY9A,В		537PY9Б,Г		
				не менее	не более	не менее	не более	
Входное напряжение высокого уровня			U _{IH}					В
	t, °C							
	+25±10			4	–	4	–	
	-60,+85*,+125* ¹							
Ток потребления в режиме хранения			I _{CCS}					мА
	U _{CC} , В	t, °C						
	5,5	+25±10			0,2		0,5	
		-60,+85*,+125* ¹		–	1	–	2,0	
	3,3	+25±10			0,12		0,3	
		-60,+85*,+125* ¹			0,6		1,2	
Ток потребления при U _{CE} - лог. “0”			I _{CC}					мА
	t, °C							
	+25±10				35		35	
	-60,+85*,+125* ¹			–	50	–	50	
Ток утечки низкого и высокого уровня на входе			I _{LIL}					мкА
	t, °C		I _{LIH}					
	+25±10			–	3	–	3	
	-60,+85*,+125* ¹				10		10	
Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии “выключено”			I _{OZL}					мкА
	t, °C		I _{OZH}					
	+25±10			–	3	–	3	
	-60,+85*,+125* ¹				10		10	
Время выборки разрешения			t _{R(CE)}					нс
	t, °C							
	+25±10				190		320	
	-60,+85*			–	220	–	400	
	+125* ¹				270		400	
Время цикла записи (считывания)			t _{CY(WR)} t _{CY(RD)}					нс
	t, °C							
	+25±10			350	–	500	–	
	-60,+85*,+125* ¹			400		580		
Время выборки адреса			t _{R(A)}					нс
	t, °C							
	+25±10				210		340	
	-60,+85*			–	240	–	420	
	+125* ¹				290		420	
Время установления сигнала разрешения после сигнала адреса			t _{SU(A-CEL)}					нс
	t, °C							
	+25±10, -60			–	20	–	20	
	+85*, +125* ¹							
Время установления сигнала записи после сигнала входной информации			t _{SU(DI-WR)}					нс
	t, °C							
	+25±10, -60			–	0	–	0	
	+85*, +125* ¹							
Время выборки сигнала разрешения выхода			t _{R(DE)}					нс
	t, °C							
	+25±10			–	70	–	70	
	-60, +85*, +125* ¹				100		100	
Время установления сигнала разрешения после сигнала считывания			t _{SU(RD-CEL)}					нс
	t, °C							
	+25±10, -60			–	20	–	20	
	+85*, +125* ¹							

Параметр		Обозначение	Норма				Единица измерения
			537PY9A,В		537PY9Б,Г		
			не менее	не более	не менее	не более	
Длительность сигнала записи		t _{W(WR)}					нс
	t, °C						
	+25±10			210		340	
	-60,+85*		—	240	—	420	
	+125* ¹			290		420	
Длительность сигнала разрешения		t _{W(CEL)}					нс
	t, °C						
	+25±10			190		320	
	-60,+85*		—	220	—	400	
	+125* ¹			270		400	
Время сохранения сигнала входной информации после сигнала записи		t _{Y(WR-DI)}					нс
	t, °C						
	+25±10, -60		—	50	—	50	
	+85*, +125* ¹						
Время сохранения выходной информации после сигнала разрешения выхода		t _{Y(DE-D0)}					нс
	t, °C						
	+25±10		—	290	—	290	
	-60, +85*, +125* ¹			390		390	
Время сохранения сигнала адреса после сигнала разрешения		t _{Y(CEH-A)}					нс
	t, °C						
	+25±10, -60		—	160	—	160	
	+85*, +125* ¹						
Емкость входа/выхода		C _{I/O}					пФ
	t, °C						
	+25±10		—	14	—	14	
Входная емкость по выводам :A0 - A10; CE, WR/RD, DE		C _I					пФ
	t, °C						
	+25±10		—	14	—	14	

Примечание:

1. Допустимое значение статического потенциала 200В
2. * - для микросхем 537PY9A, 537PY9Б
3. ¹ - для микросхем 537PY9В, 537PY9Г